

(11)Publication number:

02-150823

(43)Date of publication of application: 11.06.1990

(51)Int.CI.

G02F 1/136 G02F 1/133 H01L 27/04 H01L 27/12

(21)Application number: 63-304097

02.12.1988 (22)Date of filing:

(71)Applicant : HITACHI LTD

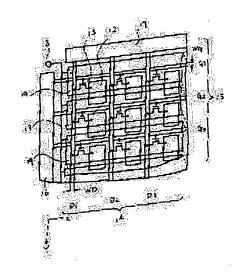
(72)Inventor: KANEKO YOSHIYUKI

MATSUMARU HARUO YAMAMOTO HIDEAKI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PURPOSE: To reduce the propagation delay of gate pulses or a data signal by forming an area where there is no conductor opposite the wiring patterns of gate lines and data lines.

CONSTITUTION: This device has a 1st substrate which has picture element electrodes 12 and thin film transistors 13 at intersection parts of data lines 14 and gate lines 15, a 2nd substrate which has a conductor 19, and a liquid crystal layer between the substrates. The 2nd substrate includes the area where there is no conductor 19 opposite the wiring patterns of the gate lines 15 and data lines 14. Namely, the area of a common electrode 19 at the part opposite the wiring patterns becomes small, so parasitic capacity becomes small. Thus, wiring capacity is reduced to secure a signal write time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A)

平2-150823

| ⊕lnt. Cl. 5 | 識別記号 | 庁内整理番号 7370-2H |
|-----------------------|------------|--------------------|
| G 02 F 1/136 1/133 | 500 550 | 8708-2H 7514-5F |
| H 01 L 27/04 27/12 | A A | 7514-5F |

❸公開 平成2年(1990)6月11日

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全7頁)

液晶表示装置 会発明の名称

顧 昭63-304097 20特

顋 昭63(1988)12月2日

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 子. 明者 @発

作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 男

治 @発 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 明 英 者 明 @発

作所中央研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ①出 顋 人

弁理士 小川 勝男 外1名 個代 理

1。発明の名称、 被晶袋示装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数のデータ線と、上記複数のデータ線と交 差する複数のゲート線を有し、上記データ線と 上記ゲート線の交差部に画素電極と上記画業電 極を駆動する薄膜トランジスタを有してなる第 1の基板と、導電体を有する第2の基板と、上 記第1および第2の基板の間の被品層とを有す る被晶袋示装置であつて、上記第2の基板は、 上記ゲート線およびデータ線のうちの少なくと も一方の配線パターンと対向する部分の少なく とも一部に上記導電体を有しない領域を含んで なることを特徴とする被晶表示装置。
 - 2.上記導電体が透明導電体であることを特徴と する請求項1記載の被基表示装置。
 - 3.上記配線パターンと対向する部分における通 明溥電体を有しない領域の幅が、上記配線パタ ーンの幅以上であることを特徴とする請求項 2

記載の被晶表示装置。

- 4.上記透明導電体が、複数の短冊状の形状を有 する透明専作体であることを特徴とする請求項 2 記載の被品表示装置。
- 5. 上記透明導電体が、メツシユ状の形状を有し てなることを特徴とする請求項2記載の被品数 示装置。
- 6. 上記複数の短冊状の透明導電体に同一の電位 が印加されることを特徴とする請求項4記段の 被晶表示装置。
- 7.上記複数の短冊状の透明導電体の間を、上記 透明導電体を構成する材料よりも低抵抗の材料 で接続してなることを特徴とする請求項6記収 の被晶表示装置。
- 8.上記低抵抗の材料が、クロムであることを特 徴とする請求項7記殻の被品表示装置。
- 9.請求項1ないし8の一に記載の被品表示装置 を用いたことを特徴とするTV画像表示装置。
- 10. 請求項 | ないし8の一に記載の被晶表示装置 を用いたことを特徴とする情報用端末あるいは

文字・図形表示装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アクテイブマトリクス型被品表示装置及びその駆動方法に係り、特に高精細・大画面の場合に良好な画質を実現するのに好適な被品表示装置に関する。

[従米の技術]

アクテイブマトリクス型被品表示装置の一般的な構成例を第2回に示す。同回において、21はマトリクス状に配された被品セル、22は電荷管積用コンデンサ、23は各被高を押したが、23は各ではいるのでは、カーの電極に対している。24はアクテータ電極に共通を構成して薄数(m 本)のデータ線 D 1~D a、25はアクテイブでしているが、25はアクテイブでは、カーをでは、カーをは、カーをは、ゲート線に順次走金パルスをを構成している。20、カーをは、ゲート線に原次走金パルスを

また線順次走金においては、第1番目のゲート線 に接続された薄膜トランジスタは同時に駆動され、 画業C・・ (k = 1 ~ m)においても各々の画像信 号は上記と同様の信号書込みが同時に行なわれる。

次に時刻 t 1+1 = t 1 + Δ t に 第 1 + 1 称目のゲート線に 薄膜トランジスタをオンする 選出 V ο κ が加えられ 画素 C 1+1 , k (k = 1 ~ m)に 倡号 各込が行なわれる。 この 信号 書込は 時刻 t 1 + 2 Δ t に終了する。以上のようにゲート線には一線 毎 に 順次 薄膜トランジスタをオンする 電圧 が加えられて 画素を 駆動することになる。

一方共通電極は一定の電位に保たれることが多く、通常画素に印加される電位の時平均の中心点 に設定される。

なおこの種の装置に関連するものとしては、例 えば特開昭54-18886 号が挙げられる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、実際の駆動においてはゲート電 ヒパルス、画像信号電圧パルスの伝播遅延を考慮 に入れなければならない。それは、ゲート配線及

印加する走査回路、27は一水平走査分の画像僧 号をデータに並列に印加する走査回路である。

次に上記の被晶表示装配の駆動について説明する。第3図は従来技術の駆動波形の例を複式的に示したものである。第1番目のゲート線に薄膜トランジスタをオンする電圧 Vonが加わるのに開閉される。これによって重要表 Ciiでは 容を である。この電像信号の ないである。 正に では である。 この電像信号の ないの である。 画像信号の ない の は、 時刻 ti + A Viで終了し 同時に ゲート 電圧は Voff となる。 画素 Ciiの電 に は Voff となる。 画素 Ciiの電 に は Voff となる。 画素 Ciiの電 に 1 フィールド 周期 T 後の 時刻 ti + T に 再び信号 番込みが行なわれるまでは、 Voiに 保持される。

びテータ配線の抵抗とそれらに寄生する静電容量によつて生ずる駆動被形の歪みである。

これについて第4図を用いて説明する。ゲート線に印加される電圧は、ゲート走査回路側で方形波であつても、そのゲート線自体の配線抵抗と容量によつて波形に歪みが生じ、走査回路と反対側の端では立上りと立下りにそれぞれ伝播遅延trs,tsを伴つた波形となる。その結果第4図の場合、信号再込時間は本米のΔtから少なくともtrsだけ短縮されることになる。加えて同様の伝播遅延がデータ信号側にも認められる場合には、上記信号ない時間はさらに短縮されてしまう。

上記の伝播遅延の値は、一般的に次のように見せることができる。第5回は、その内の主番目のゲート線のゲート伝播遅延について表わしたものである。同図にてCは1画素あたりの寄生容量であり、ゲート配線とデータ配線の交差部の容量であり、ランジスタの寄生容量、 画素部の落積容量等の合成容量で表わされる。 R は配線材料によつて支配的に決まる配線抵抗である。これらと水平

方向のデータ線数 n を用いると、伝播遅延は次式で見積もることができる。

ここで辞順トランジスタの容量変化に基づくCの 変化を考慮すれば式(1) からtasも見積もること ができる。また、データ倡号遅延についても同様 である。

ところで、スイッチング素子としての溶膜トランジスタには非晶質シリコンが多く用いられる。これはトランジスタマトリクスアレイの大面後化低コスト化に有利なためである。しから、結晶シリコンを用いたMOSトランジスタの場合、結晶シリコンを開放したMOSトランジスタの場合に示すようなようには特別昭59-123884号には、ゲート信号とデータ信号のタイとなるようで、の駆動による対策を講じて米た。

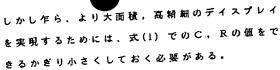
線およびデータ線のうちの少なくとも一方の配線 パターンと対向する部分の少なくとも一部に上記 導電体を有しない領域を含んでなることを特徴と オス

上記導電体として透明導電体を用いれば、透過型の被品表示装置を実現できる。

上記第2の基板上に形成される導電体の具体的な形状としては、例えばゲート線あるいはドレイン線の配線パターンと対向する部分で互いに離間された、短冊状の形状を有する複数の導電体とすることができる。あるいは上記対向する部分の一部に穴あき部(非形成部)を有するようなメッシュ形状とすることもできる。

尚、ゲート線あるいはデータ線との対向する部分で導電体を形成しない領域の幅は、本発明の効果を有効に発揮するためには、ゲート線あるいはデータ線の配線パターンの幅以上とする。より好ましくは、上記パターンの幅よりも10μm程度以上幅広としておくのが好ましい。

(作用)



特に従来技術による被晶表示装置においては、 対向基板上の共通電極を全面に形成しているため に、この共通電極と配線との間にはさまれた被晶 とで形成される容量については配慮されていなか つた。

本発明の目的は、上記ゲートパルスあるいはデータ信号の伝播遅延を小さくすることが可能な被 品表示装置を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を選成するために本発明の被晶表示装置は、複数のデータ線と、上記複数のデータ線と 交差する複数のゲート線を有し、上記データ線と 上記ゲート線の交差部に画素電極と上記画素電極 を駆動する薄膜トランジスタを有してなる第1の 基板と、導電体を有する第2の基板と、上記第1 および第2の基板の間の被晶層とを有する被晶表 示装層であつて、上記第2の基板は、上記ゲート

従来共通電極たる導電体と配線の間にはさまれていた被晶は、配線に寄生する容量の動作をするが、本発明によれば上記配線パターンとの対向部分における共通電極の面積が少なくなるので上記寄生容量は小さくなる。従つて配線容量を低減することができ信号書込時間を確保でき、良好な画質表示が実現される。

尚、上記の如く導電体の一部を有さないような 構造としても、被晶層をはさむ片方の電極として の(共通電極としての)機能には全く問題はない。 (実施例)

(実施例」)

以下、本発明の第1の実施例を第1回により説明する。第1回(a)は、本発明による被品表示 設図の模式図を斜視図で示してある。被品層をはさむ2つの基板のうち一方にはY方向に幅Woのゲート配線15とX方向に幅Woのデータ配線14を絶縁層を介して交差させ、その各交点に薄膜トランジスタ13を設けてある。これらの薄膜トランジスタにより画素電極12に信号電圧が伝 えられる。データ線にはデータドライバ17から、 ゲート線にはゲートドライバ18から信号が与え られる。他方の其板上には、短冊状に透明導電体 19が形成されている。上記釋膜トランジスタを 設けた基板と上記透明導電体の形成された基板の 間には被晶が封入されている。上記短冊状透明導 電体間の間隔は少なくともゲート電裲幅Wα 以上 とることが有効であるが、ここではWο +10μm とした。また短船状の透明導電体は、被晶封入部 外のところで互いに電気的に接続されており、共 通電極電圧18が与えられている。本発明による 共通電極形状を特に取出すと、第1図 (b) のよ うになる。共通電極の取り除かれた部分が被品を はさんでゲート電極と対向することになるので、 ゲート配線上に寄生する容量から被晶の寄与がほ とんど除かれ、ゲート信号伝播遅延が改善される という効果がある。

なお本発明は上記実施例に限定されない。特に各画素部には従来例によるように電荷著種用コン デンサが設けられていてもよいし、ゲート線・デ

これは金属と比べると高抵抗であるため、大甌面化した場合に共通電位に伝播遅延が生じることがある。本実施例ではこれを防ぐため、各透明導電層の両側で互いに電気的に接続するパターンを採用してある。

(実施例4)

実施例3の別の有効なパターンを第8図に示す。 これは透明導電体でメンシュ状パターンを形成し たものである。

(実施例5)

実施例3の別のもう一つの有効なパターンを第9回に示す。これは、データ線と同様のパターンで低抵抗金属31を用いて、透明導電体短冊間の接続を行なつたものである。接続のための材料としてここではCrを用いた。Crパターンをデータ線と被晶をはさんで向い合せ、同形状のパターンを形成させれば、画素部からの光透過量を扱うことがない。

また上記実施例3,4,5について又,Yを入れ換入実施例2のデータ線に対向する透明電極除

ータ線が直線状である必要もない。

(実施例 2) 本発明の第 2 の実施例を第 6 図を用いて示す。 群膜トランジスタを形した基板は実施例 1 によるものと同一である。 本実施例では短冊状透明の色が異なり、データ線と向きを開いている。 短冊の間隔 d はデータ線を順 W D 以上とするがここでは W D ルークタ 線の信号 はいった。 これによれば、データ線の信号 によれば、データ線の信号 にかられるというので、本実施例によればデータには、 があるられるの型がが出るというので、本実施例によればデータには、 があるられるの型がが得られば、 できるというので、 をいるというが、 でしたが、 でしたが、 でしたが、 がート線の場合と同様特に これない。

(実施例3)

第7回は、実施例1の短冊形状の場合において、 両端で互いに電気的に接続した透明導電層の構造 を示したものである。通常透明導電体としては、 ITO (インジウム・錫酸化物)が用いられるが、

去の場合に対応させても有効なことはいうまでもない。

(実施例6)

本発明の第6の実施例を第10図を用いて説明する。本実施例は、実施例1の被品表示装置を用いてTV画像表示を可能としたものである。34は通常のカラーTVに使用される標準的な駆動回路である。映像信号処理回路への入力をVTR信号とすれば、ビデオモニタとしても用いることができる。また実施例2,3,4,5に示した被品表示装置を用いてもTV画像を実現することができる。

尚、上記各実施例において、共通電極たる導電体として透明導電体を用いたが、例えば反射型の 被品級示装置に本発明を適用する場合においては 必ずしも透明である必要はない。

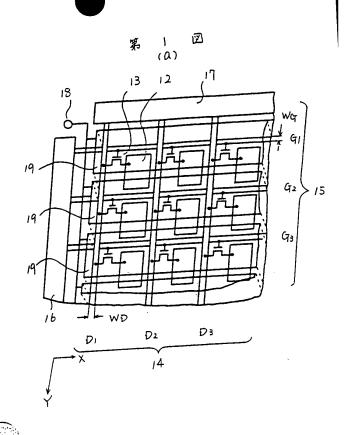
(発明の効果)

本発明による被品表示装置によれば、従来法に 比べ、ゲート配線あるいはデータ配線と対向電極 との間に生ずる静電寄生容量をほぼゼロにまで低 波できるので、大脳の一色精細のデイスプレイに 適用して良好な陋質を実現できるという効果がある。

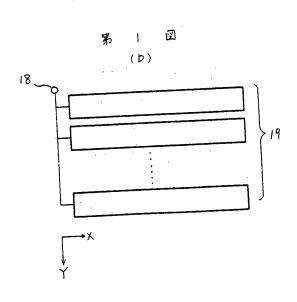
4.図面の簡単な説明

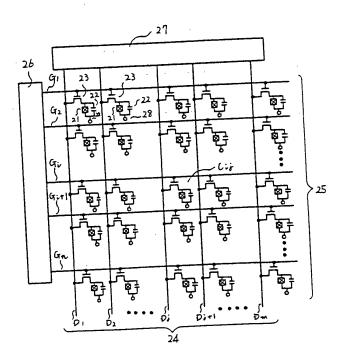
第1回は本発明の第1の実施例を説明するための図、第2回はアクテイブマトリクス型被品 表示 設置を説明するための図、第3回は従来の被品 表示 設置の駆動被形を示す図、第4回はゲートパル スの伝播遅延を説明するための図、第5回は配線 抵抗及び容量の説明図、第6回は第1の実施例に 用いた透明導電体のパターン図、第7回,第8回, 第9回,第10回はそれぞれ本発明の実施例を説 明するための図である。

代理人 弁理士 小川勝男

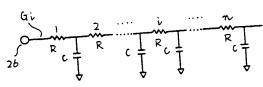


第 2 团



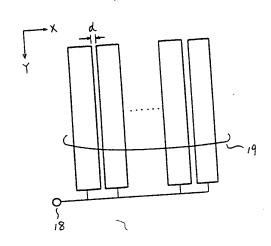


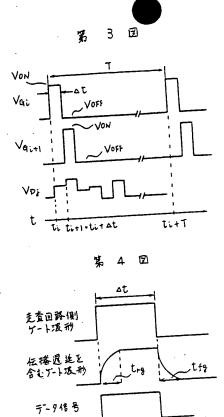
5 团

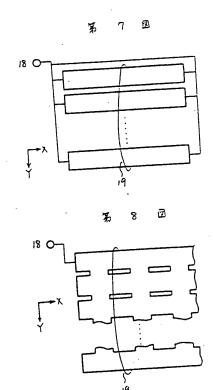


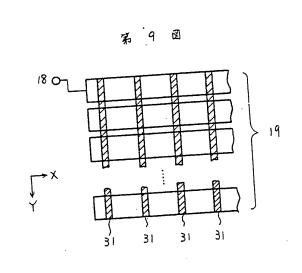
C:1画素あたりの寄生容量 R:1画素あたりの配線批抗











BEST AVAILABLE COFY

